

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

60444-1

1986

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1
1999-08

Amendement 1

**Mesure des paramètres des quartz
piézoélectriques par la technique de phase nulle
dans le circuit en pi –**

Partie 1:

**Méthode fondamentale pour la mesure de la
fréquence de résonance et de la résistance de
résonance des quartz piézoélectriques par la
technique de phase nulle dans le circuit en pi**

Amendment 1

**Measurement of quartz crystal unit parameters
by zero phase technique in a pi-network –**

Part 1:

**Basic method for the measurement of resonance
frequency and resonance resistance of quartz
crystal units by zero phase technique in
a pi-network**

© IEC 1999 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembeé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

H

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 49 de la CEI: Dispositifs piézoélectriques et diélectriques pour la commande et le choix de la fréquence.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
49/442/FDIS	49/445/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 2

SOMMAIRE

Ajouter le titre de l'annexe B comme suit:

Annexe B – Mise à jour de certaines formules de l'annexe A

Page 42

Ajouter, après l'annexe A, la nouvelle annexe B comme suit:

Annexe B (normative)

Mise à jour de certaines formules de l'annexe A

B.1 Objectifs

Dans cette annexe, certaines formules de l'annexe A sont mises à jour en prenant en considération la procédure modifiée d'étalonnage d'un réseau en π avec la résistance de référence $R_n = 25 \Omega$ à la place de la lame court-circuit.

La formule reliant R_r aux tensions mesurées est dérivée pour les valeurs arbitraires de la résistance de référence R_n . L'erreur sur R_n est prise en considération dans l'analyse des erreurs pour R_r .

La formule est donnée pour le courant et le niveau d'excitation d'un résonateur à quartz inséré dans le réseau en π . La pente de phase d'un résonateur à quartz inséré dans le réseau en π est obtenue et la formule pour Q_{eff} est corrigée.

FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 49: Piezoelectric and dielectric devices for frequency control and selection.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
49/442/FDIS	49/445/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated above.

Page 3

CONTENTS

Add the title of annex B as follows:

Annex B – Updating of some formulae of appendix A

Page 43

Add, after appendix A, the new annex B as follows:

Annex B (normative)

Updating of some formulae of appendix A

B.1 Purposes

In this annex some formulae of the appendix A are updated, taking into account the modified calibration procedure of the π -network with a reference resistor $R_n = 25 \, \Omega$ instead of a short.

The formula relating R_r to the measured voltages is derived for arbitrary values of the reference resistor R_n . The error of R_n is taken into account in the error analysis for R_r .

The formula for current and drive level of the crystal in the π -network is given. The phase slope of the crystal inserted in the π -network is derived and the formula for Q_{eff} is corrected.

B.2 Circuit en π chargé par $Z = 50 \Omega$ (avec le circuit en dérivation conforme à la figure 5a)

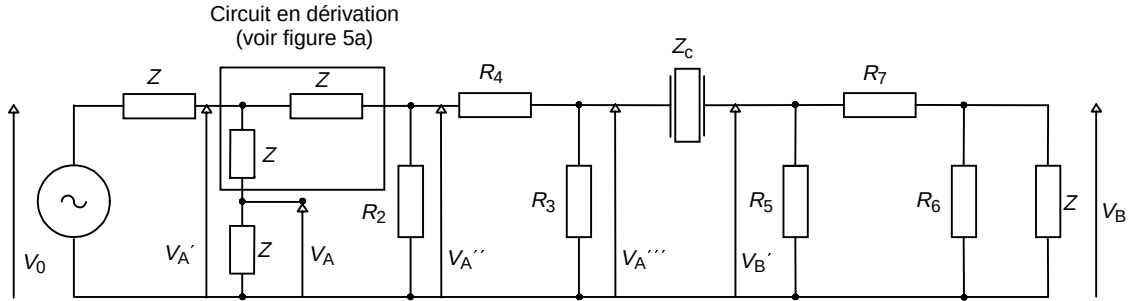


Figure B.1 – Circuit en π chargé

IEC 1019/99

B.3 Facteur de transfert de la tension d'un circuit en π chargé

Ci-dessous la dérivation élémentaire du facteur de transfert de la tension est présentée pour obtenir une formule plus complète.

$$\text{Soit } R_6' = R_6 \parallel Z = \left(\frac{1}{R_6} + \frac{1}{Z} \right)^{-1}$$

$$\text{Alors } \frac{V_B'}{V_B} = \frac{R_6'}{R_6' + R_7} = k_\pi = 0,3649 \quad (\text{B.1})$$

$$\text{Définir } R_5' = R_5 \parallel (R_6' + R_7) = \left(\frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6' + R_7} \right)^{-1} = R_{T2} = 12,5 \Omega$$

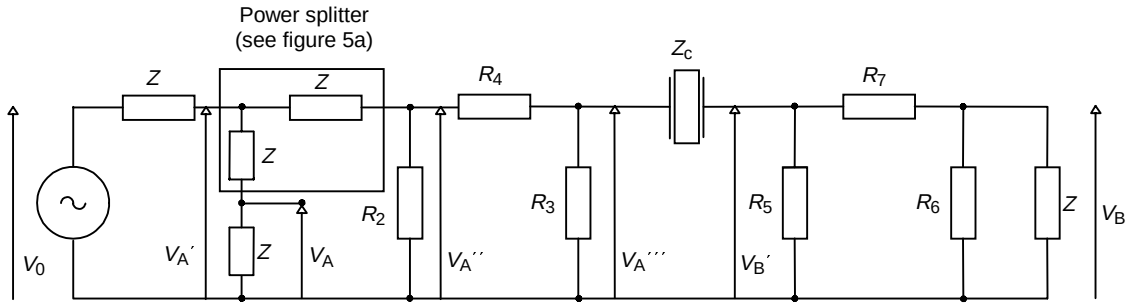
où R_{T2} est la résistance de terminaison à la sortie du circuit en π comme vu de la part d'un résonateur.

$$\text{Alors } \frac{V_B'}{V_A''} = \frac{R_5'}{R_5' + Z_c} \quad (\text{B.2})$$

$$\text{Définir } R_3' = R_3 \parallel (R_5' + Z_c) = \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5' + Z_c} \right)^{-1}$$

$$\text{Alors } \frac{V_A''}{V_A} = \frac{R_3'}{R_3' + R_4} \quad (\text{B.3})$$

B.2 The π -network terminated by $Z = 50 \Omega$ (with power splitter according to figure 5a)



IEC 1019/99

Figure B.1 – Terminated π -network

B.3 Voltage transfer factor of the terminated π -network

In the following an elementary derivation of the voltage transfer factor is presented to provide a more comprehensive formula.

$$\text{Let } R_6' = R_6 \parallel Z = \left(\frac{1}{R_6} + \frac{1}{Z} \right)^{-1}$$

$$\text{Then } \frac{V_B'}{V_B} = \frac{R_6'}{R_6' + R_7} = k_\pi = 0,3649 \quad (\text{B.1})$$

$$\text{Define } R_5' = R_5 \parallel (R_6' + R_7) = \left(\frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6' + R_7} \right)^{-1} = R_{T2} = 12,5 \Omega$$

where R_{T2} is the termination resistance at the output of the π -network as seen by the crystal.

$$\text{Then } \frac{V_B''}{V_A} = \frac{R_5'}{R_5' + Z_c} \quad (\text{B.2})$$

$$\text{Define } R_3' = R_3 \parallel (R_5' + Z_c) = \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5' + Z_c} \right)^{-1}$$

$$\text{Then } \frac{V_A'''}{V_A} = \frac{R_3'}{R_3' + R_4} \quad (\text{B.3})$$

$$\text{Définir } R_2' = R_2 \parallel \left(R_3' + R_4 \right) = \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3' + R_4} \right)^{-1}$$

Il s'ensuit que pour le circuit en dérivation conforme à la figure 5a et ne prenant pas en considération les câbles:

$$\frac{V_A''}{V_A'} = \frac{R_2'}{R_2' + Z} \quad (\text{B.4})$$

$$\text{et } \frac{V_A'}{V_A} = \frac{2Z}{Z} = 2 \quad (\text{B.5})$$

Le facteur de transfert de la tension V_B/V_A est obtenu en multipliant les formules (B.1) $\times$ (B.2) $\times$ (B.3) $\times$ (B.4) $\times$ (B.5):

$$\frac{V_B}{V_A} = \frac{V_B}{V_B'} \times \frac{V_B'}{V_A''} \times \frac{V_A''}{V_A'} \times \frac{V_A'}{V_A}$$

Après certaines substitutions et réarrangements, on peut montrer que

$$\frac{V_B}{V_A} = \frac{R_2 R_{T1} 2 Z R_{T2} R_6}{(Z(R_2 + R_4) + R_2 R_4) \times (Z(R_6 + R_7) + R_6 R_7)} \times \frac{1}{Z_c + R_{T1} + R_{T2}} \quad (\text{B.6})$$

où

$$R_{T1} = \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4 + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{Z} \right)^{-1}} \right)^{-1} = 12,5 \, \Omega$$

et

$$R_{T2} = \left(\frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_7 + \left(\frac{1}{R_6} + \frac{1}{Z} \right)^{-1}} \right)^{-1} = 12,5 \, \Omega$$

V_B/V_A est symétrique par rapport à l'entrée et à la sortie du circuit en π et se divise en un facteur qui dépend de Z et des valeurs de la résistance du circuit en π seulement, et en un facteur qui dépend de l'impédance du résonateur Z_c chargée par les impédances de terminaison du circuit en π .

$$\text{Define } R_2' = R_2 \parallel \left(R_3' + R_4 \right) = \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3' + R_4} \right)^{-1}$$

Then, for a power splitter according to figure 5a and disregarding the cables:

$$\frac{V_A''}{V_A'} = \frac{R_2'}{R_2' + Z} \quad (\text{B.4})$$

$$\text{and } \frac{V_A'}{V_A} = \frac{2Z}{Z} = 2 \quad (\text{B.5})$$

The voltage transfer factor V_B / V_A is obtained by multiplying formulae (B.1) $\times$ (B.2) $\times$ (B.3) $\times$ (B.4) $\times$ (B.5):

$$\frac{V_B}{V_A} = \frac{V_B}{V_B'} \times \frac{V_B'}{V_A'} \times \frac{V_A''}{V_A'} \times \frac{V_A''}{V_A'} \times \frac{V_A'}{V_A}$$

After some substitutions and rearrangements it can be shown that

$$\frac{V_B}{V_A} = \frac{R_2 R_{T1} 2 Z R_{T2} R_6}{(Z(R_2 + R_4) + R_2 R_4) \times (Z(R_6 + R_7) + R_6 R_7)} \times \frac{1}{Z_c + R_{T1} + R_{T2}} \quad (\text{B.6})$$

where

$$R_{T1} = \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4 + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{Z} \right)^{-1}} \right)^{-1} = 12,5 \, \Omega$$

and

$$R_{T2} = \left(\frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_7 + \left(\frac{1}{R_6} + \frac{1}{Z} \right)^{-1}} \right)^{-1} = 12,5 \, \Omega$$

V_B/V_A is symmetric with respect to the input and the output of the π -network and splits into a factor which depends only on Z and the resistance values of the π -network and a factor which depends on the crystal impedance Z_c loaded by the termination impedances of the π -network.

$$\frac{V_B}{V_A} = K (R_2 \dots R_7, Z) \times \frac{1}{Z_c + R_T}$$

où $R_T = R_{T1} + R_{T2} = 25 \Omega$.

A ce stade, les approximations ne sont pas faites. L'équation (B.6) est valable même si on admet que les résistances ont une impédance complexe.

La valeur de V_B/V_A pour $Z_c = 0 \Omega$ est

$$K/R_T = 0,0333$$

ce qui correspond à l'affaiblissement de 29,6 dB.

B.4 Calibration avec la résistance de référence $R_n = 25 \Omega$

Comme K ne dépend pas de Z_c , l'application de la formule (B.6) donne ce qui suit:

pour la résistance de référence R_n insérée dans le circuit en π ,

$$\frac{V_{Bn}}{V_{An}} = \frac{K}{R_n + R_T} \quad (B.7)$$

et pour le résonateur avec l'impédance Z_c insérée dans le circuit en π ,

$$\frac{V_{Bc}}{V_{Ac}} = \frac{K}{Z_c + R_T} \quad (B.8)$$

En divisant (B.7) par (B.8) et en résolvant l'équation pour Z_c , on obtient

$$Z_c = \frac{V_{Bn}}{V_{An}} \times \frac{V_{Ac}}{V_{Bc}} (R_n + R_T) - R_T \quad (B.9)$$

A la fréquence de résonance f_r , l'impédance du résonateur Z_c est égale à la résistance de résonance R_r , et on obtient

$$R_r = \left[\frac{V_{Bn}}{V_{An}} \times \frac{V_{Ac}}{V_{Bc}} \left(\frac{R_n}{R_T} + 1 \right) - 1 \right] R_T \quad (B.10)$$

Pour $R_n = R_T = 25 \Omega$, l'équation donnée ci-dessus a pour résultat la formule utilisée en 6.2.2.7.

$$\frac{V_B}{V_A} = K (R_2 \dots R_7, Z) \times \frac{1}{Z_c + R_T}$$

where $R_T = R_{T1} + R_{T2} = 25 \Omega$.

Thus far, no approximations have been made. Equation (B.6) holds even if the resistors are assumed to have complex impedance.

The value of V_B/V_A for $Z_c = 0 \Omega$ is

$$K/R_T = 0,0333$$

corresponding to an attenuation of 29,6 dB.

B.4 Calibration with reference resistor $R_n = 25 \Omega$

As K does not depend on Z_c , application of formula (B.6) yields:

for a reference resistor R_n inserted in the π -network

$$\frac{V_{Bn}}{V_{An}} = \frac{K}{R_n + R_T} \quad (\text{B.7})$$

for a crystal with impedance Z_c inserted in the π -network

$$\frac{V_{Bc}}{V_{Ac}} = \frac{K}{Z_c + R_T} \quad (\text{B.8})$$

By dividing (B.7) by (B.8) and solving the equation for Z_c one obtains

$$Z_c = \frac{V_{Bn}}{V_{An}} \times \frac{V_{Ac}}{V_{Bc}} (R_n + R_T) - R_T \quad (\text{B.9})$$

At the resonance frequency f_r the crystal impedance Z_c is equal to the resonance resistance R_r , which gives

$$R_r = \left[\frac{V_{Bn}}{V_{An}} \times \frac{V_{Ac}}{V_{Bc}} \left(\frac{R_n}{R_T} + 1 \right) - 1 \right] R_T \quad (\text{B.10})$$

For $R_n = R_T = 25 \Omega$ the above equation results in the formula used in 6.2.2.7.

B.5 Analyse des erreurs sur la résistance de résonance R_r

L'influence des déviations de mesure sur la résistance de résonance R_r peut être déduite à partir de l'équation (B.10).

$$\begin{aligned} \Delta R_r &= \frac{\partial R_r}{\partial V_{Bn}} \Delta V_{Bn} + \dots + \frac{\partial R_r}{\partial V_{Ac}} \Delta V_{Ac} + \frac{\partial R_r}{\partial R_n} \Delta R_n + \frac{\partial R_r}{\partial R_T} \Delta R_T \\ &= \left(\frac{\Delta V_{Bn}}{V_{Bn}} - \frac{\Delta V_{An}}{V_{An}} + \frac{\Delta V_{Ac}}{V_{Ac}} - \frac{\Delta V_{Bc}}{V_{Bc}} \right) \frac{V_{Bn}}{V_{An}} \times \frac{V_{Ac}}{V_{Bc}} (R_n + R_T) + \\ &\quad + \frac{V_{Bn}}{V_{An}} \times \frac{V_{Ac}}{V_{Bc}} \Delta R_n + \left(\frac{V_{Bn}}{V_{An}} \times \frac{V_{Ac}}{V_{Bc}} - 1 \right) \Delta R_T \end{aligned} \quad (B.11)$$

où

$\Delta V_{An}, \Delta V_{Bn}$ sont les déviations de mesure de la tension r.f. dans les canaux A et B avec une résistance de référence R_n inséré dans le circuit en π ;

$\Delta V_{Ac}, \Delta V_{Bc}$ sont les déviations de mesure de la tension r.f. dans le canaux A et B avec le résonateur à quartz inséré dans le circuit en π ;

ΔR_n est la déviation de la résistance de référence à partir de sa valeur nominale;

ΔR_T est la déviation de la résistance de terminaison d'un circuit en π (comme vu de la part du résonateur) à partir de sa valeur nominale.

Si R_n est égale à la résistance du résonateur, alors $V_{An} \approx V_{Ac}$ et $V_{Bn} \approx V_{Bc}$, et le dernier terme de la formule (B.11), contenant les erreurs sur le circuit en π , deviendra nulle.

La formule (B.11) correspond à celle de l'article A.4 de l'annexe A.

B.6 Courant sur le résonateur et niveau d'excitation dans le circuit en π

Conformément à la figure B.1, le courant sur le résonateur à la fréquence de résonance est donné par

$$I_c = \frac{(V_{Ac}''' - V_{Bc}')}{R_r} \quad (B.12)$$

A partir de l'équation (B.1), on obtient

$$V_{Bc}' = \frac{1}{k_\pi} V_{Bc}$$

La combinaison des équations (B.1) and (B.2) donne

$$V_{Ac}''' = \frac{R_r + R_{T2}}{R_{T2}} \times \frac{1}{k_\pi} V_{Bc}$$

B.5 Error analysis for the resonance resistance R_r

The influence of measuring deviations on the resonance resistance R_r can be derived from equation (B.10).

$$\begin{aligned} \Delta R_r &= \frac{\partial R_r}{\partial V_{Bn}} \Delta V_{Bn} + \dots + \frac{\partial R_r}{\partial V_{Ac}} \Delta V_{Ac} + \frac{\partial R_r}{\partial R_n} \Delta R_n + \frac{\partial R_r}{\partial R_T} \Delta R_T \\ &= \left(\frac{\Delta V_{Bn}}{V_{Bn}} - \frac{\Delta V_{An}}{V_{An}} + \frac{\Delta V_{Ac}}{V_{Ac}} - \frac{\Delta V_{Bc}}{V_{Bc}} \right) \frac{V_{Bn}}{V_{An}} \times \frac{V_{Ac}}{V_{Bc}} (R_n + R_T) + \\ &\quad + \frac{V_{Bn}}{V_{An}} \times \frac{V_{Ac}}{V_{Bc}} \Delta R_n + \left(\frac{V_{Bn}}{V_{An}} \times \frac{V_{Ac}}{V_{Bc}} - 1 \right) \Delta R_T \end{aligned} \quad (B.11)$$

where

$\Delta V_{An}, \Delta V_{Bn}$ are the measuring deviations of r.f. voltage in the channels A and B with reference resistor R_n inserted in the π -network;

$\Delta V_{Ac}, \Delta V_{Bc}$ are the measuring deviations of r.f. voltage in the channels A and B with a crystal inserted in the π -network;

ΔR_n is the deviation of the reference resistor from its nominal value;

ΔR_T is the deviation of the termination resistance of the π -network (as seen by the crystal) from its nominal value.

If R_n is equal to the crystal resistance, then $V_{An} \approx V_{Ac}$ and $V_{Bn} \approx V_{Bc}$ and the last term of formula (B.11), which contains the errors of the π -network, will vanish.

Formula (B.11) corresponds to the one in clause A.4 of appendix A.

B.6 Crystal current and drive level in the π -network

According to figure B.1 the crystal current at resonance is given by

$$I_c = \frac{(V_{Ac}'' - V_{Bc}')}{R_r} \quad (B.12)$$

From equation (B.1) one obtains

$$V_{Bc}' = \frac{1}{k_\pi} V_{Bc}$$

Combining equations (B.1) and (B.2) yields

$$V_{Ac}'' = \frac{R_r + R_{T2}}{R_{T2}} \times \frac{1}{k_\pi} V_{Bc}$$

La substitution dans l'équation (B.12) donne

$$I_c = \frac{1}{k_\pi R_{T2}} V_{Bc} = \frac{V_{Bc}}{4,56 \, \Omega} \quad (\text{B.13})$$

Le niveau d'excitation du résonateur dans le circuit en π doit alors être calculé à partir de

$$P_c = R_r \times I_c^2 \quad (\text{B.14})$$

Pour l'appareillage de mesure de la présente norme, les équations (B.13) et (B.14) sont utilisées avec $R_n = 25 \, \Omega$ au lieu de R_r , c'est-à-dire

$$I_n = \frac{1}{k_\pi R_{T2}} V_{Bn} = \frac{V_{Bn}}{4,56 \, \Omega}$$

et

$$P_n = R_n \times I_n^2$$

B.7 Courbe de phase du résonateur inséré dans la circuit en π

Si le résonateur est approximé par son bras dynamique, son impédance peut être écrite comme suit:

$$Z_c \approx R_1 + j X_1$$

$$\text{où } X_1 = \omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1}$$

La substitution de cette relation dans l'équation (B.6) donne

$$\frac{V_{Bc}}{V_{Ac}} = K \frac{1}{Z_c + R_T} = K \frac{1}{R_1 + R_T + j X_1}$$

Puisque K est réel, la phase de V_{Bc}/V_{Ac} est donnée par

$$\varphi = \arctan \left(\frac{\text{Im} \left(\frac{V_{Bc}}{V_{Ac}} \right)}{\text{Re} \left(\frac{V_{Bc}}{V_{Ac}} \right)} \right) = - \arctan \left(\frac{X_1}{R_1 + R_T} \right)$$

Substitution into equation (B.12) gives

$$I_c = \frac{1}{k_\pi R_{T2}} V_{Bc} = \frac{V_{Bc}}{4,56 \, \Omega} \quad (\text{B.13})$$

Crystal drive level in the π -network can then be calculated from

$$P_c = R_r \times I_c^2 \quad (\text{B.14})$$

For the measurement set-up in this standard, equations (B.13) and (B.14) are used with $R_n = 25 \, \Omega$ instead of R_r , i.e.

$$I_n = \frac{1}{k_\pi R_{T2}} V_{Bn} = \frac{V_{Bn}}{4,56 \, \Omega}$$

and

$$P_n = R_n \times I_n^2$$

B.7 Phase slope of the crystal inserted in the π -network

If the crystal is approximated by its motional branch, its impedance can be written as

$$Z_c \approx R_1 + j X_1$$

$$\text{where } X_1 = \omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1}$$

Substituting this relation into equation (B.6) yields

$$\frac{V_{Bc}}{V_{Ac}} = K \frac{1}{Z_c + R_T} = K \frac{1}{R_1 + R_T + j X_1}$$

As K is real, the phase of V_{Bc} / V_{Ac} is given by

$$\varphi = \arctan \left(\frac{\operatorname{Im} \left(\frac{V_{Bc}}{V_{Ac}} \right)}{\operatorname{Re} \left(\frac{V_{Bc}}{V_{Ac}} \right)} \right) = - \arctan \left(\frac{X_1}{R_1 + R_T} \right)$$

Au voisinage de résonance, l'approximation de la bande étroite (voir CEI 61080*)

$$Z_c \approx R_1 + j 2 \omega_s L_1 \left(\frac{\Delta \omega}{\omega_s} \right)$$

où $\omega_s = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}}$ et $\Delta \omega = \omega - \omega_s$, peut être utilisée.

La phase de V_{Bc}/V_{Ac} peut alors être exprimée comme suit:

$$\varphi = -\arctan \left(\frac{2 \omega_s L_1}{R_1 + R_T} \left(\frac{\Delta \omega}{\omega_s} \right) \right)$$

Pour $\Delta \omega \approx 0$, l'arctan peut être remplacé par son argument. Ainsi, une relation importante est finalement obtenue.

$$\varphi = -2 Q_{\text{eff}} \frac{\Delta f}{f_s} \quad (\text{B.15})$$

où

$$Q_{\text{eff}} = \frac{\omega_s L_1}{R_1 + R_T} \quad (\text{B.16})$$

est le facteur de qualité d'un résonateur chargé par l'impédance de terminaison d'un circuit en π .

De ce fait, la formule pour Q_{eff} donnée dans l'annexe A de cette norme n'est pas correcte et doit être remplacée par la formule (B.16) ci-dessus.

* CEI 61080:1991, *Guide pour la mesure des paramètres électriques équivalents des résonateurs à quartz.*

Near resonance the narrow band approximation (see IEC 61080*)

$$Z_c \approx R_1 + j 2 \omega_s L_1 \left(\frac{\Delta \omega}{\omega_s} \right)$$

where $\omega_s = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}}$ and $\Delta \omega = \omega - \omega_s$, can be used.

The phase of V_{Bc}/V_{Ac} then can be expressed as

$$\varphi = -\arctan \left(\frac{2 \omega_s L_1}{R_1 + R_T} \left(\frac{\Delta \omega}{\omega_s} \right) \right)$$

For $\Delta \omega \approx 0$ the arctan can be replaced by its argument. Thus, the important relation is finally obtained.

$$\varphi = -2 Q_{\text{eff}} \frac{\Delta f}{f_s} \quad (\text{B.15})$$

where

$$Q_{\text{eff}} = \frac{\omega_s L_1}{R_1 + R_T} \quad (\text{B.16})$$

is the quality factor of the crystal loaded by the termination impedance of the π -network.

The formula for Q_{eff} given in appendix A of this standard is incorrect and is therefore to be replaced by formula (B.16).

* IEC 61080:1991, *Guide to the measurement of equivalent electrical parameters of quartz crystal units*.

ISBN 2-8318-4894-6



ICS 31.140
